По материалам доклада на Третьей Российской конференции с международным участием "Стекло: наука и практика" GlasSP2021 , Санкт-Петербург, 13—17 сентября 2021 г.

# ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ Ві/Ү НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИЛИКАТНЫХ ПОРИСТЫХ СТЕКОЛ

© 2022 г. М. А. Гирсова<sup>1,</sup> \*, Г. Ф. Головина<sup>1</sup>, И. Н. Анфимова<sup>1</sup>, Л. Н. Куриленко<sup>1</sup>, Т. В. Антропова<sup>1</sup>

> <sup>1</sup>Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, наб. Макарова, 2, Санкт-Петербург, 199034 Россия

\*e-mail: girsovama@yandex.ru

Поступила в редакцию 21.04.2022 г. После доработки 03.06.2022 г. Принята к публикации 07.06.2022 г.

Синтезированы композиционные материалы (КМ) на основе матриц из высококремнеземных нанопористых стекол, активированных ионами висмута и иттрия. Проведено исследование спектрально-оптических свойств (пропускание, оптическая плотность) и характеристик оптического поглощения (энергия Урбаха) КМ в зависимости от соотношения введенного висмута и иттрия (массовое соотношение нитратов в растворе Ві/У от 1 : 1 до 10 : 1) и температуры тепловой обработки КМ (от 50 до 870°С). Методом оптической спектроскопии выявлено, что висмут в композитах находится в различных формах: сферические коллоидные частицы висмута, Bi<sup>3+</sup>,  ${\rm Bi}^{2+}, {\rm Bi}^+$  ионы;  ${\rm Bi}^{3+}_5$  поликатионы, димеры висмута. Установлено, что с ростом температуры тепловой обработки КМ происходит увеличение энергии Урбаха. Выявлено, что увеличение содержания иттрия в КМ (при прочих равных условиях) приводит к исчезновению либо появлению дополнительных полос поглощения в диапазоне 395-740 нм, связанных с висмутом, который находится в различных формах (сферические коллоидные частицы висмута,  $Bi^{3+}$ ,  $Bi^{2+}$ ,  $Bi^+$  ионы;  $Bi_5^{3+}$  поликатионы, димеры висмута). Методом ближней ИК спектроскопии у композитов идентифицированы колебания, характерные для колебаний решетки в Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, для поглощения  $Bi^+$  ионов,  $Bi^0$  и димеров висмута  $Bi_2^+$ .

**Ключевые слова:** висмутсодержащие композиционные материалы, иттрий, оптическая спектроскопия, энергодисперсионная спектроскопия, ближняя инфракрасная спектроскопия

DOI: 10.31857/S0132665122600145

#### введение

Известно, что увеличение концентрации оксида иттрия в висмутсодержащих стеклах приводит к снижению интенсивности полос поглощения, связанных с висмутом в разных степенях окисления (ионы, димеры) [1]. Оптические свойства (пропускание/поглощение в UV-VIS-NIR диапазоне спектра, показатель преломления) и энергия Урбаха висмутсодержащих стекол, активированных ионами иттрия, чувствительны к его концентрации [2–5]. Изучение влияния концентрации иттрия (в пересчете на оксид  $Y_2O_3$ ) на изменение валентного состояния висмута в висмутсодержащих стеклах представляет интерес в связи с изменением спектрально-оптических свойств материала в UV-VIS-NIR диапазоне спектра [1–5]. В настоящей работе проведено исследование синтезированных на основе пористого стекла композиционных материалов, активированных ионами висмута и иттрия, методами оптической спектроскопии, включая ближнюю ИК область, и энергодисперсионной спектроскопии в зависимости от содержания и соотношения введенных висмута и иттрия в материале.

## ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования являются композиционные материалы (КМ) на основе высококремнеземных нанопористых стекол (НПС), активированные ионами висмута и иттрия, в форме прямоугольных плоскопараллельных пластин (размером  $5-25 \times 5 15 \times 1.5 \pm 0.15$  мм). По данным химического анализа состав базовых НПС-матриц (средний диаметр пор в диапазоне 3–5 нм, пористость ~ 30%) (по анализу, мас. %): 0.30Na2O, 3.14B2O3, 0.11Al2O3, 96.45SiO2 [6]. Образцы КМ получены при комнатной температуре в подкисленных 0.5 М водно-солевых растворах пентагидрата нитрата висмута в присутствии гексагидрата нитрата иттрия (массовое соотношение нитратов в растворе Bi/Y от 1 : 1 до 10 : 1) в течение 72 ч. Обозначение синтезированных образцов в зависимости от соотношения нитратов в растворе: Bi/Y, 10Bi/Y – в соответствии с концентрацией пропитывающих растворов. При приготовлении растворов для синтеза композиционных материалов использовали реактивы: висмут азотнокислый Ві(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·5H<sub>2</sub>O ("ч. д. а.", 99.5%), 6-водный нитрат иттрия Y(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O ("х. ч.", 99.3%). Все образцы КМ были высушены при  $50^{\circ}$ С в течение 60 мин. Затем серия образцов КМ была подвергнута тепловой обработке (по специально разработанным режимам [7]) при температурах T от 50 до 870°C (на воздухе) с изотермическими выдержками в течение 15–120 мин. Внешний вид образцов КМ показан на рис. 1. Видно, что образцы KM Bi/Y при 50°C имеют розово-оранжевую окраску из-за высокой концентрации введенного нитрата иттрия. При понижении концентрации введенного нитрата иттрия (серия образцов KM 10Bi/Y) и повышении температуры тепловой обработки (≥470°С) образцы КМ становятся прозрачными и неокрашенными.

Согласно справочным данным<sup>1</sup> при термолизе азотнокислых солей висмута и иттрия происходят следующие химические превращения:

$$\operatorname{Bi}(\operatorname{NO}_3)_3 \cdot \operatorname{5H}_2 O \xrightarrow{700^\circ C} \to \operatorname{Bi}_2 O_3, \tag{1}$$

$$Y(NO_3)_3 \cdot 6H_2O \xrightarrow{>420^{\circ}C} Y_2O_3.$$
<sup>(2)</sup>

В синтезированных образцах KM, термообработанных при 650°С, методом пламенной фотометрии на спектрофотометре iCE 3000 (Thermo Fisher Scientific) было определено содержание висмута и натрия, которое в пересчете на оксиды составило, мас. %: (0.34-0.43) Na<sub>2</sub>O, (1.37-1.51) Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Стандартное квадратичное отклонение составляло 0.2-0.6%.

Элементный состав композитов изучен методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС). Измерены линейные профили концентрации элементов с шагом 20–25 мкм. Измерения проводились на сканирующем электронном микроскопе CamScan MX2500, оборудованном энергодисперсионным спектрометром Link Pentafet (Oxford Instruments, Si(Li) детектор с площадью 10 мм<sup>2</sup> и разрешающей способностью 138 eV (для MnK<sub>α</sub>)). Образцы композитов запрессовывали в полимерные шайбы,

556

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Лидин Р.А. Константы неорганических веществ: справочник / Лидин Р.А., Андреева Л.Л., Молочко В.А. М.: Дрофа, 2008. с. 685. С. 86, 188.



**Рис. 1.** Внешний вид KM в зависимости от их состава и тепловой обработки: KM Bi/Y (1–4), KM 10Bi/Y (5–8). Тепловая обработка KM (температура, длительность изотермической выдержки): при 50°C в течение 60 мин (1, 5); при 470°C в течение 60 мин (2, 6); при 650°C в течение 120 мин (3, 7); при 870°C в течение 15 мин (4, 8).

полировали и напыляли углеродом. Измерения проводили на плоскопараллельных пластинах толщиной 1.50 ± 0.15 мм.

Исследования КМ методом оптической спектроскопии проведены на спектрофотометре СФ-2000 (наименьший спектральный разрешаемый интервал 1 нм). Исследованы спектральные зависимости оптической плотности КМ в спектральном диапазоне 250–1100 нм.

Исследования КМ методом ближней ИК спектроскопии выполнены с помощью спектрофотометра ФСМ-2211 ("ИНФРАСПЕК", Россия) со спектральным разрешением 2 см<sup>-1</sup>. Исследования КМ методами оптической спектроскопии и ближней ИК спектроскопии проводили на образцах толщиной 1.50 ± 0.15 мм при комнатной температуре.

Для оценки энергии Урбаха  $E_u$  применяли подход, описанный в литературе (см., например, [8, 9]), заключающийся в проведении аппроксимации зависимости области фундаментального поглощения синтезированных КМ в соответствии с правилом Урбаха [10]. Энергию Урбаха  $E_u$  определяли в координатах (ln( $\alpha$ )– $h\nu$ ) [11], используя экспоненциальную зависимость коэффициентов поглощения  $\alpha$  от энергии фотона  $h\nu$  [8, 12]:

$$\alpha(v) = \alpha_0 \exp(hv/E_{\mu}), \qquad (3)$$

где  $\alpha_0$  – константа.

### РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Методом ЭДС были исследованы КМ в зависимости от их состава (в присутствии или без иттрия) при одинаковых условиях синтеза и температурно-временных режимах их спекания (на примере термообработки при 650°С). На рис. 2 представлены концентрационные профили элементов по толщине образцов КМ и характерные спектры элементного состава центральной части образцов КМ. Следует отметить, что



Рис. 2. Концентрационные профили элементов по толщине образцов и характерные спектры элементного состава (центральной части) образцов KM при 650°C в течение 120 мин (по данным ЭДС). KM без иттрия  $(a, \delta)$ , KM **Bi**/Y (a, c).

концентрация натрия, алюминия была нулевой, а бор и азот методом ЭДС не определяются. Из рис. 2a видно, что в пластине КМ без иттрия, содержащего 1.31 мас. %  $Bi_2O_3$ , распределение кислорода и кремния практически равномерное по всей глубине образца, в отличие от висмута, концентрация которого в поверхностном слое пластины снижена до нуля. При введении иттрия в образцы КМ концентрационные профили основных элементов (Si, O) по толщине образцов не изменяются (рис. 2a). Висмут в образцах распределен также неравномерно по толщине образцов, а иттрий, напротив, достаточно равномерно, за исключением поверхностного слоя образцов (~100 мкм) (рис. 2a). На характерных спектрах элементного состава центральной части образцов КМ (рис. 2c, c) были обнаружены пики, соответствующие основным компонентам (сильные пики – Si, O), слабые и сильные пики висмута в интервале энергий ~1.5–3.2 кэВ, слабые и сильные пики иттрия – ~1.5–2.0 и ~15.0–17.0 кэВ. Схожие данные по положению пиков иттрия были обнаружены для  $Y_2O_3$  при исследовании композитов оксид графена/оксид иттрия, полученных методом химического осаждения [13].

В табл. 1 представлены сводные данные элементного анализа образцов КМ по данным ЭДС. Указаны пределы обнаружения и средние значения концентраций элементов с указанием погрешности определения концентраций каждого элемента (в мас. %).

На рис. 3 представлены спектральные зависимости оптический плотности (диапазон 380–900 нм) КМ в зависимости от концентрации введенного иттрия (при одинаковом содержании висмута в КМ) и от температурно-временного режима спекания

|  |  | 5 |
|--|--|---|
|  |  | - |
|  |  |   |

| Образцы КМ –  | Пределы обнаружения, мас. % (среднее значение, мас. %)         |  |                            |                            |  |  |
|---------------|--|--|----------------------------|----------------------------|--|--|
|               | Si   | 0  | Bi                         | Y                          |  |  |
| KM-650        | 44.29–46.81<br>(45.17 ± 0.29)                                  | 50.87 - 53.34<br>(51.71 ± 0.33)                                | 0.00-3.72<br>(2.14 ± 0.33) | _                          |  |  |
| KM-650 (Bi/Y) | $\begin{array}{c} 42.60{-}45.72 \\ (43.62\pm0.24) \end{array}$ | $\begin{array}{c} 49.63{-}52.31 \\ (50.52\pm0.31) \end{array}$ | 0.00-4.56<br>(3.04 ± 0.27) | 0.83-2.49<br>(1.73 ± 0.30) |  |  |

Таблица 1. Элементный анализ образцов КМ по данным энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии

КМ. Выявлены полосы, связанные с присутствием висмутовых активных центров в разной степени окисления.

Полосы поглощения при 395 нм (Bi/Y, 650°C) и 397 нм (10Bi/Y, 470°C) являются характерными для  $\text{Bi}^{3+}$  ионов (электронный переход  ${}^{1}D_{2} \rightarrow {}^{3}P_{2}$ ),  $\text{Bi}_{5}^{3+}$  поликатионов, димеров висмута и сферических коллоидных частиц висмута [14-17]. Появление дополнительной слабой полосы при 440 нм (Bi/Y, 870°C) может быть связано с формированием  ${\rm Bi_5}^{3+}$  поликатионов и Bi<sup>+</sup> ионов с электронным переходом  ${}^3P_0 \rightarrow {}^1D_2$  [15, 18]. С повышением температуры тепловой обработки KM Bi/Y и KM 10Bi/Y происходит смещение полос поглощения от 470 до 490 нм, которые характерны для Bi<sup>2+</sup> ионов с электронным переходом  ${}^{2}P_{1/2} \rightarrow {}^{2}P_{3/2}(2)$  и  $\mathrm{Bi}^{+}$  ионов с электронным переходом  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{1}S_{0}$  [18–20]. Положение полос остается неизменным с повышением концентрации иттрия. Полосы при 470 и 473 нм (КМ Ві/Y и КМ 10Ві/Y; при 470, 650°С) могут быть связаны с димерами висмута и Bi<sup>0</sup> (электронный переход  ${}^{4}S_{3/2} \rightarrow {}^{2}P_{1/2}$ ), а при 487 и 490 нм (КМ Ві/У и КМ 10Ві/У; при 870°С) – с Ві<sup>0</sup> (электронный переход  ${}^{4}S_{3/2} \rightarrow {}^{2}P_{1/2}$ ) [17, 20, 21]. Наблюдаемые полосы при 560—564 нм (электронный переход  ${}^{2}P_{1/2} \rightarrow {}^{2}P_{3/2}(1))$  возможно связаны с поглощением изолированных  $\text{Bi}^{2+}$  центров [19]. Слабая полоса при 515 нм (КМ 10Ві/Ү; при 650 °С) может быть связана с Ві<sup>+</sup> ионами (электронный переход  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{1}D_{2}$ ), с Ві<sup>0</sup> (электронный переход  ${}^{4}S_{3/2} \rightarrow {}^{2}P_{1/2}$ ) и с формированием Bi<sub>5</sub><sup>3+</sup> поликатионов [15, 22, 23]. Полосы при 690-694 нм возможно относятся к Bi<sup>+</sup> ионам (электронный переход  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}P_{2}$ ) [20, 22]. Полосы при 737 и 740 нм могут быть связаны с Bi<sub>5</sub><sup>3+</sup> поликатионами, димерами висмута и Bi<sup>+</sup> ионам (электронный переход  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}P_{1}$ ) [15, 17, 24]. Полоса при 662 нм (КМ 10Ві/Y; при 470°С) может относиться к Bi<sup>+</sup> ионам [15]. Наличие полос при 530 и 535 нм возможно связано с электронным переходом  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{1}S_{0}$ , а при 598 и 637 нм с электронным переходом  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{1}D_{2}$ , которые являются характерными для Bi<sup>+</sup> ионов [23].

Полосы поглощения при 662 нм (~1.87 eV), 530 нм (~2.34 eV), 535 нм (~2.32 eV) могут быть связаны с кислородом и его вакансиями в  $Y_2O_3$  [25]. Полосы при 480 и 482 нм (KM Bi/Y и KM 10Bi/Y; при 50°С) могут быть связаны с F<sup>-</sup> центрами в Y(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O и в Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub> [26, 27].

Из рис. 3 видно, что с ростом концентрации оксида иттрия в KM (при одинаковом содержании висмута в композитах Bi/Y и 10Bi/Y) при низких температурах тепловой обработки KM (≤470°C) происходит исчезновение полос или снижение интенсивно-



**Рис. 3.** Спектры оптической плотности синтезированных композиционных материалов в зависимости от температуры их тепловой обработки и состава: КМ Ві/Y (*1–4*), КМ 10Ві/Y (*5–8*). Тепловая обработка КМ (температура, длительность изотермической выдержки): при 50°С в течение 60 мин (1, 5); при 470°С в течение 60 мин (2, 6); при 650°С в течение 120 мин (3, 7); при 870°С в течение 15 мин (4, 8).



**Рис. 4.** Зависимости логарифма коэффициента поглощения от энергии фотона для KM с разным соотношением Bi/Y: KM Bi/Y (1–3), KM 10Bi/Y (4–6). Тепловая обработка KM (температура, длительность изотермической выдержки): при 470°C в течение 60 мин (1, 4); при 650°C в течение 120 мин (2, 5); при 870°C в течение 15 мин (3, 6).

сти полос поглощения, связанных с ионами висмута в разных степенях окисления  $(Bi^{3+}, Bi^{2+}, Bi^{+})$ .

На рис. 4 представлены энергетические кривые изменения логарифма коэффициента поглощения синтезированных КМ в зависимости от их состава и тепловой обработки.

Видно, что с ростом температуры тепловой обработки (от 470 до 870°С) КМ происходит увеличение энергии Урбаха  $E_u$  от 3.01 до 3.40 эВ для КМ Ві/У и от 3.10 до 3.35 эВ для КМ 10Ві/У соответственно. Следует отметить, что с увеличением концентрации оксида иттрия в композитах наблюдается незначительное увеличение энергии Урбаха у КМ, термообработанных при 470 и 650°С, а у КМ, подвергнутых тепловой обработке при 870°С, напротив, наблюдается небольшое снижение  $E_u$ .

На рис. 5–8 представлены ИК спектры пропускания КМ, активированных ионами иттрия, в зависимости от их состава (КМ Ві/Y, КМ 10Ві/Y) и температуры тепловой обработки (50–870°С) в разных спектральных областях (11000–9000) и (9000–4000) см<sup>-1</sup>.

На рис. 5 и 6 приведены результаты в области частот 9000–4000 см<sup>-1</sup>. Видно, что у большинства образцов КМ обнаружены полосы при 7332–7320, 7161–7072, 6893–6859, 5631–5555, 5279–5237, 4533–4508 см<sup>-1</sup>. Полосы в области 7332–7320 и 7161–7072 см<sup>-1</sup> связаны с обертоном валентного колебания свободных ОН групп 2v(OH) и Si–OH групп v(Si–OH) [28, 29]. Полосы при 6893–6859 см<sup>-1</sup> относятся к поглощению гидроксильных групп 2v(OH) и сочетанию деформационных и валентных колебаний воды ( $\delta$  + v) H<sub>2</sub>O [28, 29]. Полосы при 5631–5555 см<sup>-1</sup> могут быть связаны с сочетани-ем деформационных и валентных колебаний воды ( $\delta$  + v) H<sub>2</sub>O [29].



**Puc. 5.** UK-спектры пропускания (9000–4000 см<sup>-1</sup>) KM Bi/Y в зависимости от режима тепловой обработки. Тепловая обработка KM (температура, длительность изотермической выдержки): при 50°C в течение 60 мин (1); при 470°C в течение 60 мин (2); при 650°C в течение 120 мин (3); при 870°C в течение 15 мин (4).

Составные полосы поглощения при 5279–5237 см<sup>-1</sup> приписывают сочетанию деформационных и валентных колебаний воды ( $\delta$  + v) H<sub>2</sub>O и гидроксильных групп ( $\delta$  + v) OH [28, 29]. Полосы поглощения при 4533–4508 см<sup>-1</sup> возможно связаны с валентными колебаниями OH v(OH) и Na–OH групп v(Na–OH), с деформационными колебаниями Si–OH групп  $\delta$ (Si–OH) [28–30].

У КМ Ві/Y (при 50, 470, 650°С) и КМ 10Ві/Y (при 50 и 470°С) обнаружены слабые полосы поглощения при 8706–8645 см<sup>-1</sup> (~1149–1157 нм), которые могут быть обусловлены сочетанием обертонов валентных колебаний ОН групп ( $2v_3 + 2v_1$ ) ОН [31]. Составные полосы при 8141–8103 см<sup>-1</sup> (~1228–1234 нм) (КМ Ві/Y и КМ 10Ві/Y; при 470 и 650°С) могут быть связаны с сочетанием первого обертона валентных колебаний свободных ОН групп на поверхности пористого стекла и валентных колебаний Si–O и связей 2v(OH<sub>CB</sub>) + v (Si–O), а также с сочетанием валентных колебаний ОН групп ( $2v_3 + v_1$ ) ОН [31, 32]. Полосы при 7450 см<sup>-1</sup> (~1342 нм) и 7430 см<sup>-1</sup> (~1346 нм), наблюдаемые у высушенных КМ Ві/Y и КМ 10Ві/Y при 50°С, скорее всего, относятся к обертонам валентного колебания ОН групп ( $2v_3$ ) ОН [31].



**Рис. 6.** ИК-спектры пропускания (9000–4000 см<sup>-1</sup>) КМ 10Ві/Ү в зависимости от режима тепловой обработки. Тепловая обработка КМ (температура, длительность изотермической выдержки): при 50°С в течение 60 мин (1); при 470°С в течение 60 мин (2); при 650°С в течение 120 мин (3); при 870°С в течение 15 мин (4).

У КМ Ві/Y и КМ 10Ві/Y при 870°С наблюдаются полосы при 6674, 4667 и 5060, 4656 см<sup>-1</sup> соответственно. Полоса при 6674 см<sup>-1</sup> (~1498 нм) может быть связана с обертоном ассиметричных валентных колебаний ОН групп  $v_{as}$ (OH) [33]. Полоса при 5060 см<sup>-1</sup> может быть приписана сочетанию валентных и деформационных колебаний воды ( $\delta + v$ ) (H<sub>2</sub>O) [27]. Полосы при 4667 и 4656 см<sup>-1</sup> возможно относятся к валентным колебаниям гидроксильных групп v(OH), Si–O–Si связей v<sub>3</sub>(Si–O–Si), B<sup>III</sup>–OH групп, где бор находится в тройной координации [28, 34].

У КМ Ві/Y и КМ 10Ві/Y при 470°С наблюдаются полосы при 5942 см<sup>-1</sup> (~1683 нм) и 5900 см<sup>-1</sup> (~1695 нм) соответственно, которые могут относиться к поглощению Ві<sup>+</sup> ионов [35]. У КМ Ві/Y и КМ 10Ві/Y при 50 и 470°С обнаружены полосы в области 4428–4415 см<sup>-1</sup> (~2258–2265 нм), которые, возможно, связаны с деформационными колебаниями Si–OH групп ( $\delta$ (Si–OH)), валентными колебаниями OH групп ( $\nu$ (OH)), и возможно с поглощением Ві<sup>+</sup> ионов (переход <sup>3</sup> $P_0 \rightarrow {}^{3}P_1$ ) и димеров висмута Ві<sup>+</sup> [28, 35, 36].

В другом диапазоне частот 11000–9000 см<sup>-1</sup> (рис. 7 и 8) у большинства образцов КМ обнаружены полосы в областях 10753–10739 см<sup>-1</sup> (~930–931 нм), 10563–10547 см<sup>-1</sup> (~947–948 нм) и 10484–10437 см<sup>-1</sup> (~954–958 нм), которые могут быть приписаны ко второму обертону валентных колебаний свободных групп ОН, к поглощению Bi<sup>+</sup>



**Puc. 7.** ИК-спектры пропускания (11000–9000 см<sup>-1</sup>) КМ Ві/Y в зависимости от режима тепловой обработки. Тепловая обработка КМ (температура, длительность изотермической выдержки): при 50°C в течение 60 мин (1); при 470°C в течение 60 мин (2); при 650°C в течение 120 мин (3); при 870°C в течение 15 мин (4).

ионов (электронный переход  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}P_{1}$ ) и Bi<sup>0</sup> (электронный переход  ${}^{4}S_{3/2} \rightarrow {}^{2}D_{3/2}(1)$ ) [24, 31, 32, 36]. В спектре KM 10Bi/Y, термообработанного при 870°С, наблюдается перегиб при 9655 см<sup>-1</sup> (~1036 нм), который может относиться к поглощению Bi<sup>+</sup> ионов (электронный переход  ${}^{3}P_{0} \rightarrow {}^{3}P_{1}$ ) и Bi<sup>0</sup> (электронный переход  ${}^{4}S_{3/2} \rightarrow {}^{2}D_{3/2}(1)$ ) [24, 31, 32, 36]. Полосы при 10484–10475 (термообработка при 470–870°С) и 9655 см<sup>-1</sup> (при 870°С) могут быть связаны с колебанием решетки в Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> [37].

Следует отметить, что изменение температурно-временного режима тепловой обработки КМ приводит к изменению их спектральных свойств. Это проявляется в исчезновении или смещении полос, ответственных за поглощение гидроксильных групп и колебания воды.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе синтезированы композиционные материалы на основе матриц из высококремнеземных нанопористых стекол с соотношением нитратов Ві и Y в растворе, равным 1 : 1 и 10 : 1. Композиционные материалы подвергнуты тепловой обработке при температуре, изменяющейся в интервале от 50 до 870°С.

Проведено исследование спектрально-оптических свойств композитов методами оптической и ближней инфракрасной спектроскопии в зависимости от соотношения



**Рис. 8.** ИК-спектры пропускания (11000–9000 см<sup>-1</sup>) KM 10Bi/Y в зависимости от режима тепловой обработки. Тепловая обработка KM (температура, длительность изотермической выдержки): при 50°C в течение 60 мин (1); при 470°C в течение 60 мин (2); при 650°C в течение 120 мин (3); при 870°C в течение 15 мин (4).

содержания введенного висмута и иттрия и температурно-временных режимов тепловой обработки композитов.

Установлено, что висмут в синтезированных композитах находится в разных формах в зависимости от их состава и режима тепловой обработки.

Тепловая обработка KM приводит к формированию  $Bi^{2+}$  и  $Bi^+$  ионов, а в случае низкотемпературной обработки ( $\leq 470^{\circ}$ C) и  $Bi_5^{3+}$  поликатионов, димеров висмута  $Bi_2^{+}$ . На спектрах большинства синтезированных композитов, включая образцы с высокотемпературной обработкой ( $870^{\circ}$ C) помимо полос, связанных с поглощением  $Bi^+$  ионов, наблюдаются полосы, обусловленные присутствием  $Bi^0$ . Обнаружены полосы, которые могут быть связаны с кислородными вакансиями в  $Y_2O_3$  (при  $470^{\circ}$ C) и с колебанием решетки в  $Y_2O_3$  (при  $470^{\circ}$ C).

Показано, что с ростом температуры тепловой обработки (от 470 до 870°С) КМ происходит увеличение энергии Урбаха  $E_u$  от 3.01 до 3.40 эВ для КМ Ві/У и от 3.10 до 3.35 эВ для КМ 10Ві/У соответственно. Установлено, что повышение концентрации иттрия в композитах приводит к незначительному увеличению энергии Урбаха у КМ при 870°С (от 3.35 до 3.40 эВ). Напротив, при 470 и 650°С у серий КМ Ві/У по сравнению с КМ 10Ві/У наблюдается небольшое снижение  $E_u$ .

Отмечено, что изменение концентрации иттрия в КМ (при прочих равных условиях) приводит к исчезновению либо появлению полос в диапазоне при 395–740 нм, связанных висмутом, который находится в различных формах (сферические коллоидные частицы висмута,  $Bi^{3+}$ ,  $Bi^{2+}$ ,  $Bi^+$  ионы;  $Bi_5^{3+}$  поликатионы, димеры висмута, а также появлению полосы при 662 нм (кислород и его вакансии в  $Y_2O_3$ ).

Методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии установлено, что висмут в композитах КМ Ві/Y (на примере термообработки при 650°С) распределен неравномерно по толщине образцов, а иттрий, напротив, достаточно равномерно, за исключением поверхностного слоя образцов.

Авторы признательны А.В. Антонову (ФГУП ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) за исследования композитов методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХС РАН при поддержке Минобрнауки России (Государственная регистрация № АААА-А19-119022290087-1 и № 1021050501068-5-1.4.3 (проект FFEM-2022-0004)).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Hughes M.A., Suzuki T., Ohishi Y. Compositional optimization of bismuth-doped yttria-aluminasilica glass // Optical Materials. 2009. V. 32. P. 368–373.
- Saddeek Y.B., Aly K., Abbady Gh., Afify N., Shaaban KH. S., Dahshan A. Optical and structural evaluation of bismuth alumina-borate glasses doped with different amounts of (Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) // J. Non-Crystalline Solids. 2016. V. 454. P. 13–18.
- Shaaban M.H., Ali A.A. Density, Electrical and Optical Properties of Yttrium-Containing Tellurium Bismuth Borate Glasses // J. Electronic Materials. 2014. V. 43. P. 4023–4032.
- Shaaban Kh.S., Al-Baradi A.M., Wahab E.A.A. The Impact of Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> on Physical and Optical Characteristics, Polarizability, Optical Basicity, and Dispersion Parameters of B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>-Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub> Glasses // Silicon. 2022. V. 14. P. 5057–5065.
- 5. Dai N., Wang Y., Xu B., Yang L., Luan H., Li J. Effect of yttrium oxide addition on absorption and emission properties of bismuth-doped silicate glasses // J. Rare Earths. 2012. V. 30. № 5. P. 418–421.
- Antropova T., Girsova M., Anfimova I., Drozdova I., Polyakova I., Vedishcheva N., Structure and spectral properties of the photochromic quartz-like glasses activated by silver halides // J. Non-Cryst. Solids. 2014. V. 401. P. 139–141.
- Патент 2605711. Способ изготовления люминесцентного висмутсодержащего кварцоидного материала на основе высококремнеземного пористого стекла / Антропова Т.В., Гирсова М.А., Анфимова И.Н., Головина Г.Ф., Куриленко Л.Н., Фирстов С.В.; заявитель и патентообладатель Институт химии силикатов им. И.В. Гребенщикова. № 2015117713/05; заявл. 12.05.2015; опубл. 27.12.2016, Бюл. № 36. 17 с.
- 8. *Kaur G., Kumar M., Arora A., Pandey O.P., Singh K.* Influence of Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> on structural and optical properties of SiO<sub>2</sub>–BaO–ZnO–xB<sub>2</sub>O<sub>3</sub>–(10 x) Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> glasses and glass ceramics // J. Non-Crystalline Solids. 2011. V. 357. P. 858–863.
- 9. Федюнин Ф.Д., Спасский Д.А. Правило Урбаха и оценка ширины запрещенной зоны в молибдатах // Физика твердого тела. 2020. Т. 62. № 8. С. 1179–1186. [Fedyunin F.D., Spassky D.A. Urbach Rule and Estimation of the Energy Gap width in Molybdates // Physics of the Solid State. 2020. V. 62. № 8. Р. 1325–1332].
- 10. Urbach F. The Long-Wavelength Edge of Photographic Sensitivity and of the Electronic Absorption of Solids // Physical Review J. Archive. 1953. V. 92. № 5. P. 1324–1324.
- Wood D.L., Tauc J. Weak Absorption Tails in Amorphous Semiconductors // Physical Review B. 1972. V. 5. № 8. P. 3144–3151.
- Mergen O.B., Arda E. Determination of Optical Band Gap Energies of CS/MWCNT Bio-nanocomposites by Tauc and ASF Methods // Synthetic Metals. 2020. V. 269. P. 116539/1–116539/9.
- 13. Shanmugapriya T., Balavijayalakshmi J. Role of graphene oxide/yttrium oxide nanocomposites as a cathode material for natural dye-sensitized solar cell applications // Asia-Pacific J. Chemical Engineering. 2021. V. 16. № 2, article e2598. P. 1–12.
- 14. Fan X., Su L., Ren G., Jiang X., Xing H., Hu J., Tang H., Li H., Zheng L., Qian X., Feng H. Influence of thermal treatment on the near-infrared broadband luminescence of Bi:CsI crystals // Optical Materials Express. 2013. V. 3. № 3. P. 400–406.
- Romanov A.N., Fattakhova Z.T., Veber A.A., Usovich O.V., Haula E.V., Korchak V.N., Tsvetkov V.B., Trusov L.A., Kazin P.E., Sulimov V.B. On the origin of near-IR luminescence in Bi-doped materials(II). Subvalent monocation Bi<sup>+</sup> and cluster Bi<sub>5</sub><sup>+</sup> luminescence in AlCl<sub>3</sub>/ZnCl<sub>2</sub>/BiCl<sub>3</sub> chloride glass // Opt. Express. 2012. V. 20. № 7. P. 7212–7220.
- 16. Романов А.Н., Хаула Е.В., Корчак В.Н. Образование и оптические свойства ИК фотолюминесцентных центров в алюмофосфатном стекле, содержащем висмут // Квантовая электроника. 2020. Т. 50. № 10. С. 910–916.

- 17. Sokolov V.O., Plotnichenko V.G., Dianov E.M. Origin of broadband near-infrared luminescence in bismuth-doped glasses // Optics Letters. 2008. V. 33. № 13. P. 1488–1490.
- Zhou S., Jiang N., Zhu B., Yang H., Ye S., Lakshminarayana G., Hao J., Qiu J. Multifunctional Bismuth-Doped Nanoporous Silica Glass: From Blue-Green, Orange, Red, and White Light Sources to Ultra-Broadband Infrared Amplifiers // Advanced Functional Materials. 2008. V. 18. № 9. P. 1407–1413.
- Hamstra M.A., Folkerts H.F., Blasse G. Red Bismuth Emission in Alkaline-earth-metal Sulfates // J. Mater. Chem. 1994. V. 4. № 8. P. 1349–1350.
- Li X., Cao J., Wang L., Peng M. Predictable tendency of Bi NIR emission in Bi-doped magnesium aluminosilicate laser glasses // J. American Ceramic Society. 2018. V. 101. P. 1159–1168.
- Zhang J., Han L., Guan Z., Jia B., Peng Z., Guan X., Yan B., Peng G.-D., Lu P. Electronic and Luminescence Characteristics of Interstitial Bi° Atom in Bismuth-Doped Silica Optical Fiber // J. Luminescence. 2019. V. 207. P. 346–350.
- Xu Z., Yan J., Xu C., Zhang H., Chen G., Liu X., Qiu J. Effect of SiO<sub>2</sub> on optical properties of bismuth-doped B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-GeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub> glasses // Applied Physics B. 2018. V. 124, article 178. P. 1–7.
- Sun H.-T., Hosokawa A., Miwa Y., Shimaoka F., Fujii M., Mizuhata M., Hayashi S., Deki S. Strong Ultra-Broadband Near-Infrared Photoluminescence from Bismuth-Embedded Zeolites and Their Derivatives // Advanced Materials. 2009. V. 21. P. 3694–3698.
- Peng M., Zollfrank C., Wondraczek L. Origin of broad NIR photoluminescence in bismuthate glass and Bi-doped glasses at room temperature // J. Phys.: Condens. Matter. 2009. V. 21, article 285106. P. 1–6.
- 25. Mikhailov M.M., Neshchimenko V.V., Chundong L., Utebekov T.A. Absorption Band of Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Microand Nanopowders Induced by Proton and Electron Bombardment // J. Surface Investigation: Xray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2017. V. 11. № 4. P. 827–831.
- Pujats A., Springis M. The F-type centres in YAG crystals // Radiation Effects and Defects in Solids: Incorporating Plasma Science and Plasma Technology. 2001. V. 155. P. 65–69.
- 27. Зоренко Ю.В., Волошиновский А.С., Констанкевич И.В. Люминесценция F<sup>+</sup> и F-центров в YAlO<sub>3</sub> // Оптика и спектроскопия. 2004. Т. 96. № 4. С. 591–596. [Zorenko Yu.V., Voloshinovskiæ A.S., Konstankevych I.V. Luminescence of F<sup>+</sup> and F Centers in YAlO<sub>3</sub> // Optics and Spectroscopy. 2004. V. 96. № 4. P. 532–537].
- 28. Gavrilko T., Gnatyuk I., Puchkovska G., Baran J., Marchewka M., Morawska-Kowal T. Application of NIR spectroscopic method to the study of porous glasses filled with liquid crystals // Optica Applicata. 2003. V. 33. № 1. P. 23–32.
- Davis K.M., Tomozawa M. An infrared spectroscopic study of water-related species in silica glasses // J. Non-Crystalline Solids. 1996. V. 201. P. 177–198.
- 30. Zotov N., Keppler H. The influence of water on the structure of hydrous sodium tetrasilicate glasses // American Mineralogist. 1998. V. 83. № 7–8. P. 823–834.
- Humbach O., Fabian H., Grzesik U., Haken U., Heitmann W. Analysis of OH absorption bands in synthetic silica // J. Non-Crystalline Solids. 1996. V. 203. P. 19–26.
- Никитин В.А., Сидоров А.Н., Карякин А.В. Исследование адсорбции обычной и тяжелой воды на микропоистом стекле по инфракрасным спектрам поглощения // Журн. физической химии. 1956. Т. 30. Вып. 1. С. 117–128.
- Kloprogge J.T., Schuiling R.D., Ding Z., Hickey L., Wharton D., Frost R.L. Vibrational spectroscopic study of syngenite formed during the treatment of liquid manure with sulphuric acid // Vibrational Spectroscopy. 2002. V. 28. P. 209–221.
- Bauer U., Behrens H., Fechtelkord M., Reinsch S., Deubener J. Water- and boron speciation in hydrous soda-lime-borate glasses // J. Non-Crystalline Solids. 2015. V. 423–424. P. 58–67.
- 35. Sokolov V.O., Plotnichenko V.G., Dianov E.M. Centers of near-IR luminescence in bismuth-doped TlCl and CsI crystals // Optics Express. 2013. V. 21. № 8. P. 9324–9332.
- 36. Plotnichenko V.G., Philippovskiy D.V., Sokolov V.O., Golovanov V.F., Polyakova G.V., Lisitsky I.S., Dianov E.M. Infrared luminescence in bismuth-doped AgCl crystals // Optics Letters. 2013. V. 38. № 16. P. 2965–2968.
- 37. *Nigara Y.* Measurement of the Optical Constants of Yttrium Oxide // Japanese J. Applied Physics. 1968. V. 7. № 4. P. 404–408.